

Физика и техника полупроводников, 2022, том 56, выпуск 3

Шабалдин А.А., Самунин А.Ю., Константинов П.П., Новиков С.В., Бурков А.Т., Bu Zhonglin, Pei Yanzhong Влияние термической предыстории на свойства эффективных термоэлектрических сплавов $\text{Ge}_{0.86}\text{Pb}_{0.1}\text{Bi}_{0.04}\text{Te}$	261
Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)	
Бессолов В.Н., Коненкова Е.В., Середова Н.В., Пантелеев В.Н., Щеглов М.П. Анизотропные напряжения в слоях GaN(1120) на подложке $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ при хлорид-гидридной газофазной эпитаксии	266
Боднарь И.В., Хорошко В.В. Аномалии теплового расширения и теплопроводности монокристаллов $\text{CuIn}_7\text{Se}_{11}$	271
Казарова О.П., Нагалюк С.С., Солтамов В.А., Музафарова М.В., Мохов Е.Н. Высокотемпературная диффузия акцепторной примеси Be в AlN	275
Семягин Б.Р., Колесников А.В., Путятю М.А., Преображенский В.В., Попова Т.Б., Ушанов В.И., Чалдышев В.В. Выращивание слоев $\text{GaAs}_{1-x}\text{Bi}_x$ методом молекулярно-лучевой эпитаксии	279
Шиманский А.Ф., Кравцова Е.Д., Кулаковская Т.В., Григорович А.П., Копыткова С.А., Смирнов А.Д. Исследование взаимосвязи механических напряжений, оптической неоднородности и концентрации кислорода в кристаллах германия	285
Гарибова С.Н., Исаев А.И., Мехтиева С.И., Атаева С.У., Алекперов Р.И. Влияние режима получения образцов и термообработки на локальную структуру халькогенидного полупроводника $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$	291
Дашдамирова Г.Е., Аскеров Э.Б., Исмаилов Д.И. Фазообразование и кинетика кристаллизации аморфных пленок CuIn_5S_8	297
Электронные свойства полупроводников	
Гурбанов Г.Р., Адыгезалова М.Б. Синтез и термоэлектрические свойства твердого раствора $\text{Sn}_{1-x}\text{Pb}_x\text{Sb}_4\text{Te}_8$, легированного висмутом	302
Спектроскопия, взаимодействие с излучениями	
Агеева Н.Н., Бронева И.Л., Забегаев Д.Н., Кривонос А.Н. Функциональные зависимости максимальной плотности энергии спектральной компоненты стимулированного пикосекундного излучения GaAs при насыщении усиления. Остаточное характерное время релаксации излучения	307
Поверхность, границы раздела, тонкие пленки	
Иванов А.Ф., Егоров Ф.С., Платонов Н.Д., Матухин В.Л., Теруков Е.И. Влияние кислорода при осаждении тонкой пленки оксида индия-олова методом магнетронного распыления для гетеропереходных солнечных элементов	315
Тысченко И.Е., Спесивцев Е.В., Шкляев А.А., Попов В.П. Структурные изменения в пленках кремний-на-изоляторе нанометровой толщины при высокотемпературном отжиге	320
Гольдман Е.И., Чучева Г.В., Шушарин И.А. Форма изолирующего потенциала, создаваемого сверхтонкими слоями оксида кремния	328
Николаев С.Н., Багаев В.С., Чернопицкий М.А., Усманов И.И., Онищенко Е.Е., Деева А.А., Кривобок В.С. Низкотемпературная фотолюминесценция монослоя WSe_2, полученного механическим слоением с использованием золота	

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления	335
Басалаева Л.С., Царев А.В., Аникин К.В., Вебер С.Л., Крыжановская Н.В., Настаушев Ю.В. Оптические свойства кремниевых нанопилларов со встроенным вертикальным р-п-переходом	340
Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники	349
Prosanov I.Yu., Sidelnikov A.A., Hanna S.A. Synthesis of polymeric CdS and its optical properties investigation	350
Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники	357
Моисеев А.Н., Евстигнеев В.С., Чилиясов А.В., Костюнин М.В. Влияние условий осаждения из паров металлоорганических соединений на получение эпитаксиальных слоев n-CdTe с использованием изопропилиодида	350
Физика полупроводниковых приборов	357
Бабичев А.В., Колодезный Е.С., Гладышев А.Г., Денисов Д.В., Jollivet A., Quach P., Карачинский Л.Я., Неведомский В.Н., Новиков И.И., Tchernycheva M., Julien F.H., Егоров А.Ю. Гетероструктура квантово-каскадного детектора частотного диапазона 2.5 ТГц	357
Муретова М.Е., Зубов Ф.И., Асрян Л.В., Шерняков Ю.М., Максимов М.В., Жуков А.Е. Конструкции блокирующих слоев для подавления паразитной рекомбинации в мощных диодных лазерах с GaAs волноводом	363
Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур	370
Папикян А., Арутюнян С., Агамалян Н., Овсепян Р., Хачатурова А., Петросян С., Бадалян Г., Кафадарян Е. Термоэлектрические и мемристивные особенности структур $Sb_2Te_3/Sb_2S_3/Sb_2Te_3$ и $Ag/Sb_2Te_3/Ag$	370
Малевская А.В., Ильинская Н.Д., Малевский Д.А., Покровский П.В. Электрохимическое осаждение контактных материалов в постростовой технологии фотоэлектрических преобразователей	376